SiC JFET採用 800 A / 800 V バッテリー ディスコネクト ユニット

SiC JFETを6並列に用いた、800 A / 800 Vクラス対応のバッテリー ディスコネクト ユニット。メカリレー相当の400 µΩの超低オン抵抗を実現します。

システム アプローチ

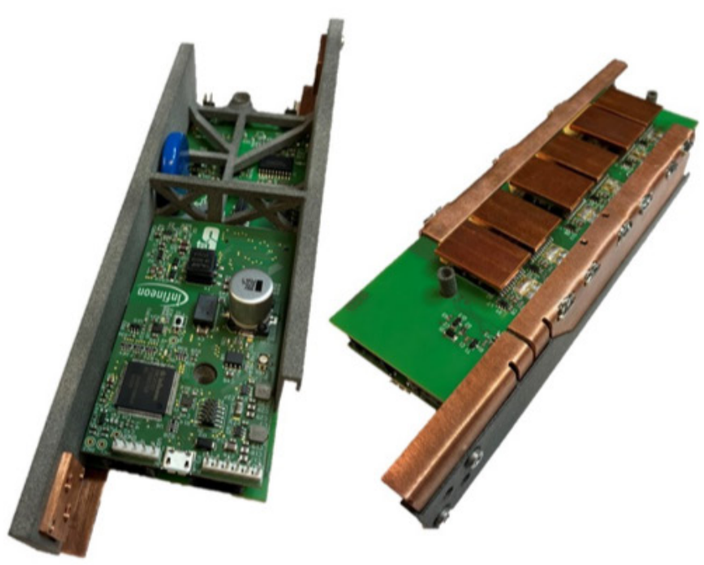
- 上面放熱機構 WBG (SiC JFET) パワー半導体の採用
- 1200 V SiC JFET採用で、メカリレー相当の低損失
- 上面放熱 + ヒート スプレッダーを用いた放熱構造により小型化

注目製品

- CoolSiC™ JFET IJCQ120RM23J1
- TLE5571電流センサー

カスタマー ベネフィット

- JFETによる小型化
- デモンストレーターを用いたシステム レベルの評価が可能



Voltage	up to 850V dc
Current	800 A(*) DC
Product	6 x IJCQ120RM23J1
$R_{DS(on)}$	498 µΩ
Temperature	-40°C .. 85°C
Dimensions	204 x 62 x 41 mm